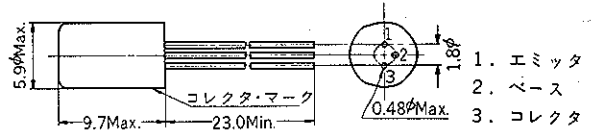


外形寸法図(単位: mm)

三洋2SA182ⓈはゲルマニウムP-N-P合金接合型トランジスタです。高品質、高信頼性が要求される工業用に設計されていますので低周波、高周波増幅用はもちろん、中速度スイッチングまで幅広く優れた性能を発揮します。



絶対最大定格

周囲温度25℃

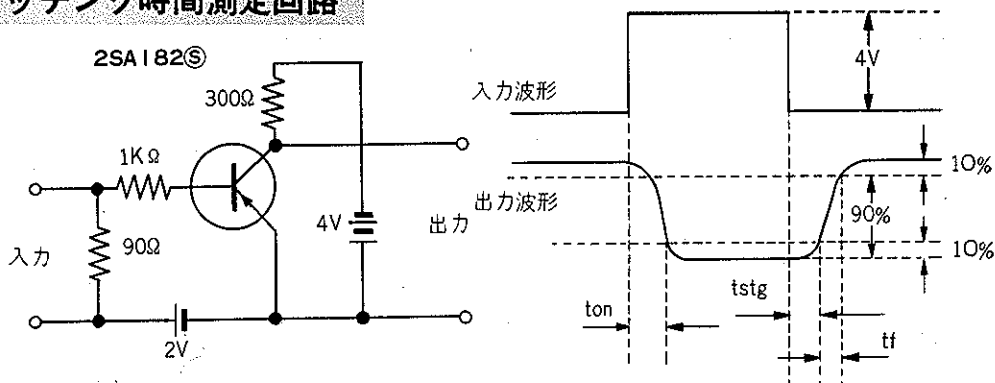
項目	記号	2SA182Ⓢ	単位
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	-25	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	-12	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	-12	V
コレクタ電流	I_C	-100	mA
コレクタ損失	P_C	100	mW
接合部温度	T_j	75	℃
保存温度	T_{stg}	-55~+85	℃

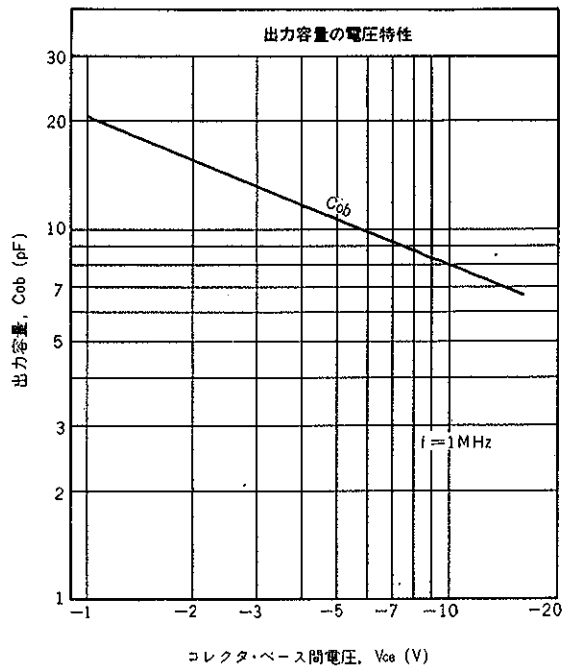
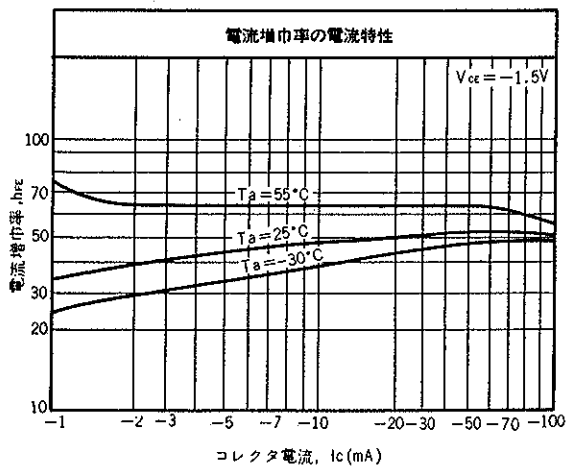
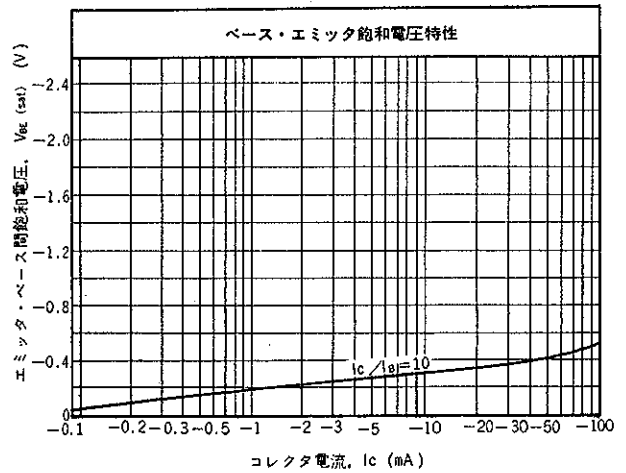
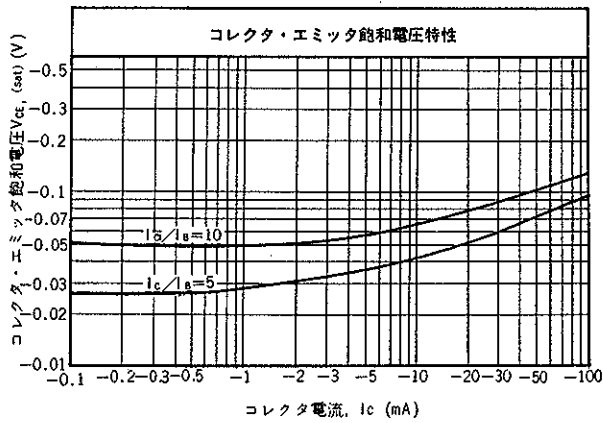
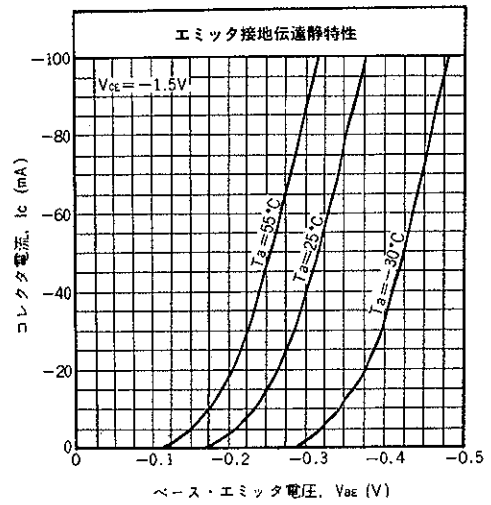
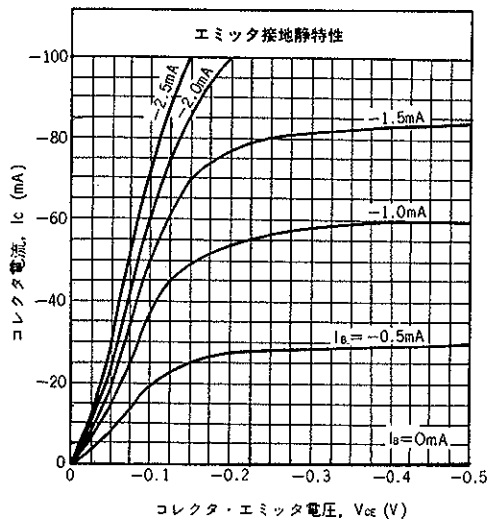
電気的特性

周囲温度25℃

項目	記号	試験条件	2SA182Ⓢ			単位
			最小	標準	最大	
コレクタ遮断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = -15V, I_E = 0$			-5	μA
エミッタ遮断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = -12V, I_C = 0$			-10	μA
コレクタ・エミッタ破壊電圧	BV_{CEO}	$I_C = -1mA, R_{BE} = \infty$	-12			V
直流電流増幅率	h_{FE}	$V_{CE} = -1.5V, I_C = -30mA$		50		
遮断周波数	$f_{\alpha b}$	$V_{CB} = -6V, I_C = -1mA$	5			MHz
出力容量	C_{ob}	$V_{CB} = -6V, I_E = 0, f = 1MHz$		11	15	pF
飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -100mA, I_B = -10mA$		-0.1	-0.3	V
	$V_{BE(sat)}$			-0.4	-0.8	
スイッチング時間	t_{on}	(条件は測定回路図参照)		0.3		μs
	t_{stg}			0.3		
	t_f			0.16		

スイッチング時間測定回路





TOKYO SANYO ELECTRIC CO., LTD.
 SEMICONDUCTOR DIVISION FIELD SALES OFFICES
 TOKYO 6-15-13 Sotokanda Chiyodaku Tokyo Japan 101
 (HEAD OFFICE) Tel: (Tokyo) 03-832-3141
 OSAKA 1-1 Sanyo-cho Daito City Osaka Japan 574.
 Tel: (Daito) 0720-72-2121
 GUMMA 180 Sakata Ohizumi-machi Ohra-gun Gumma Japan 370-05
 Tel: (Ohizumi) 0276-6-2111